

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年8月5日(05.08.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/065654 A1

(51) 国際特許分類7:

C23C 14/00, 16/00, B08B 3/08

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/000540

(22) 国際出願日:

2004年1月22日(22.01.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-015266

2003年1月23日(23.01.2003) Ъ

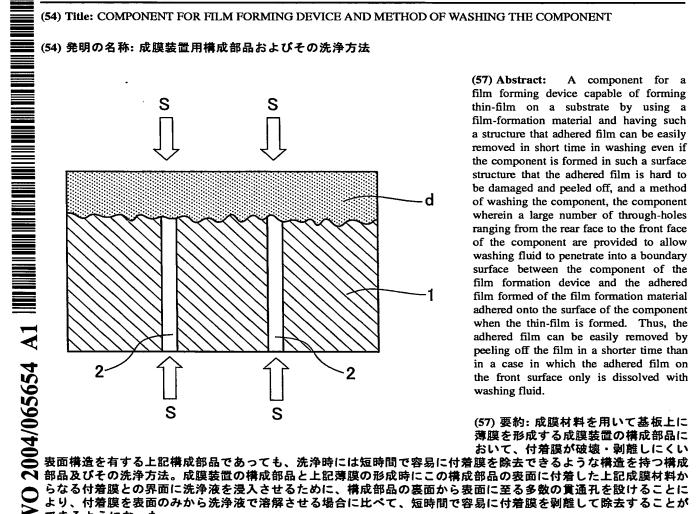
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会 社アルバック (ULVAC, INC.) [JP/JP]; 〒2538543 神奈 川県茅ヶ崎市萩園2500番地 Kanagawa (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 平田 招佑 (HI-RATA, Akisuke) [JP/JP]; 〒2891297 千葉県山武郡山武

町横田516株式会社アルバック内 Chiba (JP). 磯田 伸二(ISODA, Shinji)[JP/JP]; 〒2891297 千葉県山武郡 山武町横田516株式会社アルバック内 Chiba (JP). 門脇 豊 (KADOWAKI, Yutaka) [JP/JP]; 〒2891297 千 葉県山武郡山武町横田516株式会社アルバック内 Chiba (JP). 虫明 克彦 (MUSHIAKE, Katsuhiko) [JP/JP]; 〒1620055 東京都新宿区余丁町 4 - 1 4 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 東田 潔 . 外(TOHDA, Kiyoshi et al.); 〒 1500021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目6番2号大 進ビル6階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,

[続葉有]

- (54) Title: COMPONENT FOR FILM FORMING DEVICE AND METHOD OF WASHING THE COMPONENT



らなる付着膜との界面に洗浄液を浸入させるために、構成部品の裏面から表面に至る多数の貫通孔を設けることに より、付着膜を表面のみから洗浄液で溶解させる場合に比べて、短時間で容易に付着膜を剝離して除去することが できるようになった。

LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU,

MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。



- 1 -

明細書

成膜装置用構成部品およびその洗浄方法

技術分野

本発明は、基板上に成膜材料による各種薄膜を形成する成膜装置の構成部品お よびその洗浄方法に関する。

背景技術

LSI(大規模集積回路)、太陽電池、液晶プラズマディスプレイなどに使用 されている半導体製品は、成膜材料から蒸着、スパッタリング、CVD、その他 の方法によって、基板上に薄膜を形成する成膜装置内で製造される。

上記成膜材料は、薄膜形成時に成膜装置内の基板マスクなどの防着板やウェハ の支持枠などの構成部品の表面にも付着膜を形成する。

上記付着膜は、同一成膜装置内で基板を交換して成膜処理を繰り返すことによ って厚く堆積し、ある時点でその堆積膜が破壊したり剥離脱落して発塵などの原 因となり、成膜途上の基板に塵埃が付着して目的とする膜の特性を害するおそれ があり、製造される半導体製品の歩留まりを低下させる。

そこで、上記付着膜を除去する方法として、例えば、付着膜が付いた構成部品 を洗浄液に浸漬して付着膜を溶解させる洗浄方法が採用されている。

上記洗浄を行うためには、付着膜が破壊や剥離脱落する前に成膜装置の運転を 停止して行わなければならないが、付着膜が破壊・剥離脱落する前の時点を見極 めることは困難である。一方、破壊・剥離脱落する前の時点を見極めることなく 頻繁に洗浄を行うと、成膜装置の稼動効率が低下するという問題が生じている。

従来、上記問題を解決するために、特開平8-277460号公報で開示され ているように、付着膜が厚く付着しても破壊・剥離脱落しにくい図3記載の表面 構造を有する構成部品が提供されてきた。この表面構造を有する構成部品を使用 することによって、ある程度付着膜が厚く堆積しても破壊・剥離脱落することが なくなり、また、上記洗浄を頻繁に行う必要がなくなったため、成膜装置の稼動 効率も改善されるようになった。

図3の(a)は、構成部品を構成する母材31の表面に小径の鋼球を噴射するショットプラストあるいはガラス玉を噴射するガラスピーズプラストなどのプラスト処理を施して凹凸を形成させたものである。この凹凸によって母材31の表面積が増大し、付着膜dの付着力が増大するため、付着膜dの破壊・剥離脱落が阻止される。

図3の(b)は、構成部品を構成する母材32の表面に切削加工やエンボス加工などの機械的加工方法により凹凸面を形成させたものである。この場合、付着膜dの剥離しようとする応力によって母材32の表面が変形されてこの応力を緩和するため、付着膜dの破壊・剥離脱落が阻止される。

図3の(c)は、母材33の表面を上記のようにブラスト処理した後、その上に柔らかい金属を被覆することによって母材33の表面に層34を設けたものである。この軟らかい層34によって、付着膜dの破壊・剥離応力を緩和させ、付着膜dの破壊・剥離脱落が阻止される。

上記従来技術の表面構造を有する構成部品であっても、成膜処理を繰り返すことによっていずれは付着膜が破壊・剥離脱落するため、構成部品を再生利用する ためには洗浄する必要が生じる。

しかしながら、上記表面構造を有する構成部品は、そもそも付着膜が破壊・剥離脱落しにくい構造としてあるので、洗浄液で付着膜を完全に溶解、除去するためには、洗浄に多大な時間を要し、成膜装置の稼動効率を低下させていた。

また、付着膜の除去に時間がかかることによって、構成部品自体も洗浄液に長時間浸漬しなければならず、構成部品が洗浄液によってダメージを受けるおそれがあった。

洗浄に時間がかかる場合には、新たな構成部品に交換することも考えられるが、 近年、大規模液晶画面のニーズに応じて大型化している基板マスクなどの場合、 頻繁に交換することが却ってコストと手間をかける結果となるため、洗浄によっ て付着膜を除去し、再生利用することが強く求められている。



そこで、本発明は、上記問題点に鑑み、付着膜が破壊・剥離脱落しにくい上記 表面構造を有する構成部品であっても、洗浄時には短時間で容易に付着膜を除去 できるような構造を持つ成膜装置用構成部品を提供することを目的とする。

発明の開示

上記問題点を解決するため、本発明にかかる成膜装置用構成部品は、成膜材料を用いて基板上に薄膜を形成する成膜装置の構成部品において、この構成部品と上記薄膜の形成時にこの構成部品の表面に付着した上記成膜材料からなる付着膜との界面に、洗浄液を浸入させるために、構成部品の裏面から表面に至る多数の 貫通孔を設けたことを特徴とする。

この構成によれば、上記構成部品を洗浄液に浸漬した場合、この洗浄液は付着膜を表面から溶かすほか、上記貫通孔からも浸入して構成部品と付着膜との界面からも付着膜を溶かすため、付着膜が全部溶ける前に、構成部品から付着膜を剥離することが可能となる。

しかし、上記構成部品に付着膜が付着していない薄膜形成の初期段階では、上記貫通孔に、成膜材料粒子が進入し、あるいは成膜時に発生するプラズマが浸入して、構成部品を取り付けてある装置本体に付着膜が堆積してしまうおそれがある。

そこで、貫通孔に、成膜材料粒子が進入し、あるいはプラズマが浸入することを阻止するためには、上記貫通孔の径を、上記成膜材料粒子の進入若しくはプラズマの浸入ができない大きさにするか、上記貫通孔を上記構成部品の表面に対して光学的めくら状態、例えば鉛直方向に貫通させないように傾斜させて設ければよい。

ところで、上記構成部品の表面に、洗浄液に対して易溶性の性質を有する金属 膜からなる層を溶射、蒸着、スパッタリング、メッキ、ラミネート等の方法で形 成した場合、付着膜はこの層の上に堆積する。

この場合、洗浄液は、層の端部から浸透するほか、貫通孔からも層に浸透して 層を溶かすため、付着膜を短時間で剥離することができる。 なお、成膜処理中は、この層が成膜材料粒子の進入やプラズマの浸入を阻止する蓋の役割を果たす。

本発明にかかる成膜装置用構成部品の洗浄方法は、表面に付着膜が形成された上記各構成部品、すなわち、構成部品の裏面から表面に至る多数の貫通孔を設けたもの、上記貫通孔の径を上記成膜材料粒子の進入若しくはプラズマの浸入ができない大きさにしたもの、上記貫通孔を上記構成部品の表面に対して鉛直方向に貫通させないように傾斜させて設けたもの、あるいは上記構成部品の表面に、洗浄液に対して易溶性の性質を有する金属膜からなる層を溶射、蒸着、スパッタリング、メッキ、ラミネート等の方法で形成したもののうちいずれかの構成部品を洗浄液に浸漬させたことを特徴とする。

この方法によれば、成膜装置用構成部品を浸漬した洗浄液は、付着膜の表面から溶解するほか、上記各貫通孔からも浸入して付着膜を溶解して付着膜を上記構成部品から剥離する。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明にかかる構成部品を部分拡大した断面図である。

第2図は成膜材料粒子等が貫通孔に進入しない構造を有する構成部品を部分拡大した断面図であり、(a)は貫通孔の径を成膜材料粒子の進入もしくはプラズマの浸入ができない大きさにした場合の断面図、(b)は貫通孔を母材の表面から裏面へと鉛直方向に貫通させないように傾斜させた場合の断面図、(c)は母材の表面に洗浄液に対して易溶性の性質を有する金属膜からなる層を形成させた場合の断面図である。

第3図は、付着膜が破壊・剥離脱落しにくい表面構造を有する従来の構成部品 を部分拡大した断面図であり、(a) は表面をプラスト処理した場合の断面図、

(b) は表面に切削加工やエンボス加工などの機械的加工方法により凹凸面を形成させた場合の断面図、(c) は表面に柔らかい金属を形成させた場合の断面図である。

発明を実施するための最良の形態

図1を参照して、1は成膜装置用構成部品を構成する母材を拡大したものである。母材1によって構成される構成部品としては、例えば成膜装置内の基板マスクやウェハの支持枠などがある。

成膜装置内で成膜材料によって基板上に薄膜を形成させると、基板以外の上記 構成部品にも付着膜dが付着する。

この付着膜dは、上記成膜装置内で基板を交換して成膜処理を繰り返すことによって厚く堆積し、ある時点で破壊・剥離脱落して発塵の原因となり、成膜途上の基板に付着して目的とする膜の特性を害するおそれがある。

この付着膜dを取り除くためには、例えば、母材1を洗浄液Sに浸漬して除去すればよいが、従来は上記洗浄液Sが上記付着膜dを表面からのみ溶かしていたため、付着膜dの除去には時間がかかっていた。特に付着膜dが剥離しにくいように母材1の表面構造を工夫している場合、洗浄液Sを付着膜dの表面からのみ溶かしていたのでは、洗浄の途中で付着膜dが剥離することはほとんどないので、付着膜dの除去のためには、付着膜dが洗浄液Sによってすべて溶けるのを待つしかなかった。

また、付着膜dがすべて溶けるのを待つために、母材1を洗浄液Sに長時間浸漬すると、洗浄液Sによって母材1もダメージを受けるおそれがあった。

そこで、本発明では、母材1に多数の貫通孔2を設けることによって、母材1を洗浄液Sに浸漬した場合、洗浄液Sが、母材1の表面や端面から付着膜dを溶かすとともに、上記多数の貫通孔2から洗浄液Sが浸入し、付着膜dと母材1との界面も溶かすようにした。

母材1に多数の貫通孔2を設けることによって、洗浄液Sが付着膜dをすべて 溶かす前に、付着膜dと母材1との界面から付着膜dを溶かして剥離することが できるため、付着膜dの表面からのみ溶かす従来の洗浄に比べ、短時間で容易に 付着膜dを除去することができる効果が得られる。

また、従来に比べ、短時間で付着膜 d を除去できるので、母材 1 が洗浄液 S に 浸漬される時間も短縮され、洗浄液 S による母材 1 のダメージも軽減される。 なお、貫通孔2の数は母材1の強度を損ねない範囲であれば、特に限定されるものでないが、例えば隣接する2つの貫通孔2の間隔が3cm~5cmであれば上記効果は得られる。

ところで、貫通孔2に、付着膜dを形成する成膜材料粒子が進入し、あるいは プラズマが浸入すると、構成部品を取り付けている装置本体に付着膜dを堆積し てしまうおそれある。

そこで、貫通孔 2 を、成膜材料粒子の進入やプラズマの浸入を阻止する構造に する必要がある。

図2の(a)~(c)は、貫通孔2を、成膜材料粒子の進入やプラズマの浸入を阻止する構造にした実施形態の例を拡大した断面図であるが、本発明の趣旨に 逸脱しない範囲であれば、これらの実施形態に限定されるものではない。

なお、図2の(a)の母材11及び(b)の母材12の表面構造は、プラスト 処理したものであるが、他の表面構造であってもよい。

図2の(a)では、母材11に設けられた貫通孔21の径を、上記プラズマPが浸入及び通過できない0.8mm ϕ にした。

貫通孔21の径を上記の大きさにすることによって、プラズマPが貫通孔21 に浸入及び通過することを阻止することができる。

図2の(b)では、貫通孔22を母材12の表面から裏面へと鉛直方向に貫通させないように傾斜させて光学的にめくら状態にした孔を設けた。

貫通孔22を有する母材12から成る構成部品を使用すれば、基板の成膜処理中には、成膜材料粒子やプラズマは、貫通孔22の表面側の開口部から貫通孔22の内壁に衝突し、貫通孔22の内部に進入若しくは浸入することがほとんどできないため、構成部品を取り付けている装置本体に付着膜dが堆積することを阻止することができる。

図2の(c)では、母材13の表面に洗浄液に対して易溶性の性質を有する金 属膜からなる層14を溶射して形成したものである。

成膜処理中は、この層14が成膜材料粒子の進入やプラズマの浸入を阻止する 蓋の役割を果たす。 なお、付着膜dは、上記層14の上に堆積する。この層14は、基板への成膜処理中は、付着膜dの破壊・剥離応力を緩和させ、付着膜dの破壊・剥離脱落を防止する役割を果たすが、洗浄液Sに浸漬した場合は、母材13よりも速く洗浄液Sに反応して溶解し、付着膜dを母材13から剥離させる機能を有する。

従来、洗浄液Sはこの層14の両端からのみ浸透していたが、貫通孔23を設けることにより、層14の各所に洗浄液Sが到達し、従来に比べて短時間で付着膜を剥離することができる。

産業上の利用可能性

以上のように、本発明にかかる成膜装置用構成部品およびその洗浄方法は、この構成部品と上記薄膜の形成時にこの構成部品の表面に付着した上記成膜材料からなる付着膜との界面に洗浄液を浸入させるために、構成部品の裏面から表面に至る多数の貫通孔を設けることにより、付着膜の表面のみから洗浄液で溶解させる場合に比べて、短時間で容易に付着膜を剥離して除去することができるで、この構成部品は、基板マスクなどの防着板やウェハの支持枠など、成膜材料から蒸着、スパッタリング、CVD、その他の方法によって、基板上に薄膜を形成する成膜装置の構成部品などに用いるのに適している。

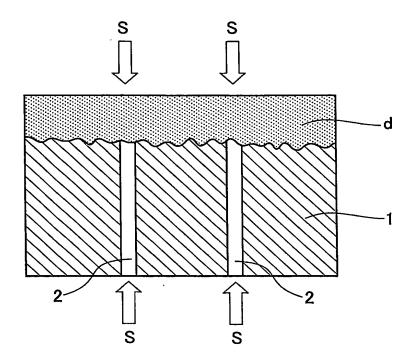


請求の範囲

- 1. 成膜材料を用いて基板上に薄膜を形成する成膜装置の構成部品において、この構成部品と上記薄膜の形成時にこの構成部品の表面に付着した上記成膜材料からなる付着膜との界面に、洗浄液を浸入させるために、構成部品の裏面から表面に至る多数の貫通孔を設けたことを特徴とする成膜装置用構成部品。
- 2. 上記貫通孔の径を、上記成膜材料粒子の進入若しくはプラズマの浸入ができない大きさにしたことを特徴とする請求項1記載の成膜装置用構成部品。
- 3. 上記貫通孔を上記構成部品の表面に対して鉛直方向に貫通させないように傾斜させて設けたことを特徴とする請求の範囲1又は請求の範囲2記載の成膜装置用構成部品。
- 4. 上記構成部品の表面に、洗浄液に対して易溶性の性質を有する金属膜からなる層を溶射、蒸着、スパッタリング、メッキ、ラミネート等の方法で形成したことを特徴とする請求の範囲1記載の成膜装置用構成部品。
- 5. 請求の範囲1記載の構成部品に形成された付着膜を剥離するために、この構成部品を洗浄液に浸漬させたことを特徴とする成膜装置用構成部品の洗浄方法。
- 6. 請求の範囲 2 記載の構成部品に形成された付着膜を剥離するために、この構成部品を洗浄液に浸漬させたことを特徴とする成膜装置用構成部品の洗浄方法。
- 7. 請求の範囲3記載の構成部品に形成された付着膜を剥離するために、この構成部品を洗浄液に浸漬させたことを特徴とする成膜装置用構成部品の洗浄方法。
- 8. 請求の範囲4記載の構成部品に形成された付着膜を剥離するために、この構成部品を洗浄液に浸漬させたことを特徴とする成膜装置用構成部品の洗浄方法。



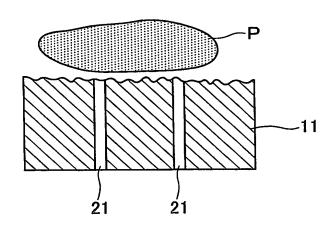
【第1図】



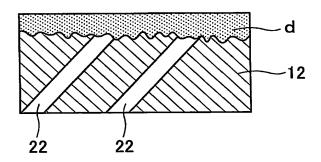
2/3

【第2図】

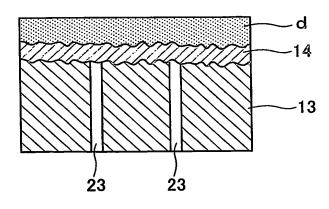
(a)



(b)



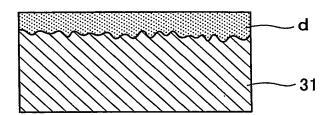
(c)



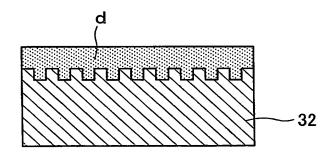
3/3

【第3図】

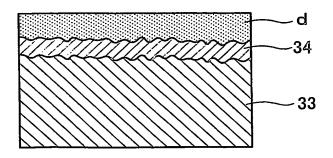
(a)



(b)



(c)





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/000540

A CLASSIFIC Int.Cl7	ATION OF SUBJECT MATTER C23C14/00, C23C16/00, B08B3/08	·					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS SE							
Minimum docum	nentation searched (classification system followed by class	sification symbols)					
Int.CI	C23C14/00-C23C16/56, B08B1/00,	B08B3/00-13/00					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched							
Jitsuyo Shinan Koho 1922—1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996—2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971—2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994—2004							
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)							
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category*	Citation of document, with indication, where app	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
A	US 5628839 A (NIHON SHINKU GI	JUTSU KABUSHIKI	1-8				
	KAISHA),		•				
	13 March, 1997 (13.03.97), Full text	:					
		5755887 A					
	& KR 266873 B	•					
A	JP 5-230624 A (Fujitsu Ltd.),		1-8				
	07 September, 1993 (07.09.93)	,					
	Full text						
	(Family: none)						
A	JP 63-66901 B2 (Fujitsu Ltd.)	,	1-8				
ļ	22 December, 1988 (22.12.88),						
	Full text (Family: none)						
	(1000)						
Further d	locuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention					
· ·		'X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive					
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is		step when the document is taken alone					
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination					
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than		being obvious to a person skilled in the	e art				
	y date claimed	"&" document member of the same patent	family				
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international sea					
13 Ap	ril, 2004 (13.04.04)	27 April, 2004 (27	.04.04)				
		Authorized officer					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer					
		Telephone No.					
Facsimile No.		Telephone No.					





国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2004/000540

A.	発明の属	する分野の分類(国際特許分類(IPC))					
	Int. Cl	C23C14/00, C23C16/00, B08B3/08	•				
B. 調査を行った分野							
調	査を行った最	小限資料(国際特許分類(IPC))					
	Int. Cl	C23C14/00~C23C16/56, B08B1/00, I	B08B3/00~13/00 .	1			
 							
最 		⊦の資料で調査を行った分野に含まれるもの 用新案公報 1922−1996年					
	日本国英用新菜公報 1922—1996年 1922—1922—1996年 1922—1996年 1922—1922—1922—1922—1922—1922—1922—1922						
	日本国実用新案登録公報 1996-2004年						
日本国登録実用新案公報 1994-2004年							
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)							
				İ			
c	関連する						
-	用文献の			関連する			
カ	テゴリー*			請求の範囲の番号			
	Α	US 5628839 A (NIHON SHINKU GIJUTSU KABUSHIKI KAISHA)					
		1997.03.13, 全文, & JP 8-277460 A, & US 5755887 A, & KR 266873 B					
		全义, & JP 8-2//400 A, & US 3/338	6/ A, & KR 2006/3 B				
	Α	JP 5-230624 A (富士通株式会社) 1993.09.07,		1-8			
	全文、(ファミリーなし)						
	Α	JP 63-66901 B2 (富士通株式会社) 19	88.12.22,	1-8			
		全文、(ファミリーなし)					
F	 C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。			
	* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって						
	もの出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論						
	│ 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの │ 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明						
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行の新規性又は進歩性がないと考えられるもの							
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合							
	「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献よって進歩性がないと考えられるもの						
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献							
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日							
13. 04. 2004				2004			
国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4G 9278							
日本国特許庁 (ISA/JP) 宮澤 尚之							
	귬수	郵便番号100-8915 [都千代田区霞が関三丁目4番3号	 電話番号 03-3581-1101	内線 2⊿16			
ı	果 方	(34) 17(円段段が表示丿月4借3万	「毎mara co cocr yior	I 102 O T T O			